

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **11097825 A**

(43) Date of publication of application: **09 . 04 . 99**

(51) Int. Cl.

H05K 3/32
C09J 5/06
C09J 9/02
C09J 11/04
C09J157/00
H01L 21/60

(21) Application number: **09252932**

(22) Date of filing: **18 . 09 . 97**

(71) Applicant: **HITACHI CHEM CO LTD**

(72) Inventor: **FUJINAWA MITSUGI**
WATANABE ITSUO
ARIFUKU MASAHIRO

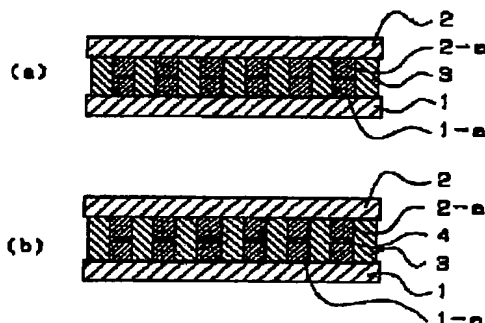
(54) **STRUCTURE AND METHOD FOR CONNECTING
CIRCUIT ELECTRODE**

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a connecting structure and a connecting method of a circuit electrode using hardening binding material by superior radical polymerization at low-temperature quick hardening.

SOLUTION: A substrate 1 is made of an insulating substrate such as plastics. A substrate 2 facing opposite the substrate 1 comprises a same material. A circuit electrode 1-a is provided on the surface of the substrate 1 as a copper foil. A circuit electrode 2-a is provided on the surface of the substrate 2 as a copper foil, and a gold surface layer is formed. Adhesive agent 3 requires inevitably a curing agent for generating free radical by heating and radical curing agent. The radical hardening anisotropic conducting binding material, wherein conducting particles 4 are dispersed by the specified amount, is used. After the temporary connecting structure, the circuit electrode 1-a of the substrate 1 and the circuit electrode 2-a of the substrate 2 are aligned in positions, heating and compression are performed at a heat plate 5 from the upper side of the substrate 2, and main connection is completed.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-97825

(43) 公開日 平成11年(1999) 4月9日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号

F I

H 0 5 K 3/32

H 0 5 K 3/32

B

C 0 9 J 5/06

C 0 9 J 5/06

9/02

9/02

11/04

11/04

157/00

157/00

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 4 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平9-252932

(22) 出願日 平成9年(1997) 9月18日

(71) 出願人 000004455

日立化成工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72) 発明者 藤縄 貢

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式
会社筑波開発研究所内

(72) 発明者 渡辺 伊津夫

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式
会社筑波開発研究所内

(72) 発明者 有福 征宏

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式
会社筑波開発研究所内

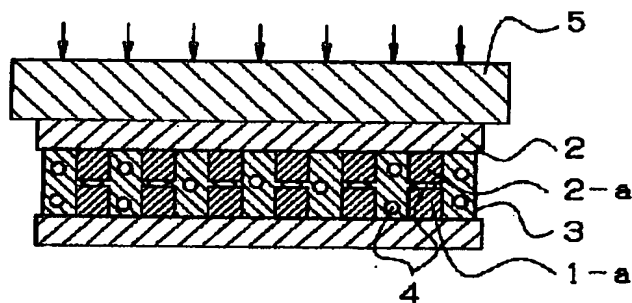
(74) 代理人 弁理士 若林 邦彦

(54) 【発明の名称】 回路電極の接続構造および回路電極の接続方法

(57) 【要約】

【課題】 低温速硬化性に優れるラジカル重合による硬化性の接着剤を用いた回路電極の接続構造及び接続方法を提供する。

【解決手段】 基板1はプラスチック等の絶縁基板であり、これに対向する基板2も同様な材質からなる。回路電極1-aは基板1の表面に銅箔で設けたものである。回路電極2-aは基板2の表面に銅箔で設けたもので、金の表面層が形成されている。接着剤3は加熱により遊離ラジカルを発生する硬化剤およびラジカル硬化性の物質を必須とする接着剤であり、導電性粒子を所定量分散したラジカル硬化性の異方導電性接着剤が使用される。仮接続構造の後に、基板1の回路電極1-aと基板2の回路電極2-aを位置合わせし、基板2上方より熱板5にて所定時間の加熱加圧を行い本接続を完了する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 相対峙する回路電極が回路接続材料を介して電氣的に接続された回路電極の接続構造であって、前記回路電極の少なくとも一方の表面が遷移金属族から選ばれる金属であり、前記回路接続材料がラジカル重合による硬化性を有する回路接続材料であることを特徴とする回路電極の接続構造。

【請求項 2】 ラジカル重合による硬化性を有する回路接続材料が、導電性粒子を含有する異方導電性接着剤である請求項 1 記載の回路電極の接続構造。

【請求項 3】 異方導電性接着剤の導電性粒子の表面が金、銀及び白金族から選ばれる貴金属である請求項 2 記載の回路電極の接続構造。

【請求項 4】 ラジカル重合による硬化性を有する回路接続材料を一方の電極回路に形成した後、もう一方の回路電極を位置合わせし加熱、加圧して接続する工程を 6 日以内に行う請求項 1 記載の回路電極の接続構造を製造する回路電極の接続方法。

【請求項 5】 ラジカル重合による硬化性を有する回路接続材料を表面が金、銀、錫及び白金族から選ばれる金属である一方の電極回路に形成した後、表面が遷移金属族から選ばれる金属であるもう一方の回路電極を位置合わせし加熱、加圧して接続する請求項 1 記載の回路電極の接続構造を製造する回路電極の接続方法。

【請求項 6】 ラジカル重合による硬化性を有する回路接続材料が、導電性粒子を含有する異方導電性接着剤である請求項 4 又は 5 記載の回路電極の接続方法。

【請求項 7】 異方導電性接着剤の導電性粒子の表面が金、銀及び白金族から選ばれる貴金属である請求項 6 記載の回路電極の接続方法。

【請求項 8】 回路基板を有する基板の少なくとも一方を 50℃以上の温度で 1 時間以上加熱処理する請求項 4 ～ 7 各項記載の回路電極の接続方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は相対峙する回路電極の接続構造および接続方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 回路電極の接続方法として、はんだや共晶などの従来のリジッドな接続に比べ、ソフトな接続が得られ、熱応力の緩和が可能な接着剤による接続が近年盛んに行われている。接着剤としては、粒子等の導電材料を所定量含有することで、加圧もしくは加熱加圧等により、加圧方向のみに導電性を有する、いわゆる異方導電性接着剤が主に検討されている。異方導電性接着剤による接続は、接続すべき回路電極の一方、もしくは両方に液状の異方導電性接着剤を塗布したり、フィルム状の異方導電性接着剤を載置するなどして形成（仮接続）し、もう一方の電極回路を位置合わせし、通常 160℃ ～ 180℃ の温度で 20 秒程度の加熱加圧により多数の

回路電極を一括接続（本接続）するもので、エポキシ樹脂を主体とした硬化性の異方導電性接着剤が検討されている。この際、仮接続後に生産行程の調整のために一定期間（例えば 1 週間程度）放置される場合がある。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、回路電極の高密度化により回路電極の位置ずれを防止するために、上記温度よりも低温の 140℃での接続が望まれている。この対策として反応性に優れるラジカル硬化性の接着剤の使用が考えられるが、この接続方法で表面がニッケルや銅などの遷移金属の回路電極を用いて接続を行う場合、ラジカル硬化性の接着剤を回路電極に載置形成（仮接続）後一定期間放置すると、酸化還元作用によりラジカル重合が進行してしまい接着剤が流動しにくくなり、本接続時に十分な電氣的接続ができない。本発明は、従来のエポキシ樹脂系よりも低温速硬化性に優れるラジカル重合による硬化性の接着剤を用いた回路電極の接続構造及び接続方法を提供するものである。

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明の回路電極の接続構造は、相対峙する回路電極が回路接続材料を介して電氣的に接続された回路電極の接続構造であって、前記回路電極の少なくとも一方の表面が遷移金属族から選ばれる金属であり、前記回路接続材料がラジカル重合による硬化性を有する回路接続材料であることを特徴とする。回路電極の接続構造。本発明の回路電極の接続方法は、ラジカル重合による硬化性を有する回路接続材料を一方の電極回路に形成した後、もう一方の回路電極を位置合わせし加熱、加圧して接続する工程を 6 日以内に行い前記回路電極の接続構造を製造する。また本発明の回路電極の接続方法は、ラジカル重合による硬化性を有する回路接続材料を表面が金、銀、錫及び白金族から選ばれる金属である一方の電極回路に形成した後、表面が遷移金属族から選ばれる金属であるもう一方の回路電極を位置合わせし加熱、加圧して接続し前記の回路電極の接続構造を製造する。ラジカル重合による硬化性を有する回路接続材料としては、導電性粒子を含有する異方導電性接着剤が使用され、異方導電性接着剤の導電性粒子としては表面が金、銀及び白金族から選ばれる貴金属である導電性粒子が使用される。

【0005】 すなわち本発明は、ラジカル重合による硬化性を有する接着剤を用いて、相対峙する回路電極を電氣的に接続する接続方法を鋭意検討した結果、回路電極の少なくとも一方の表面を金、銀、白金族、または錫とし、この面にラジカル硬化性の接着剤を載置形成（仮接続）後、本接続することにより、良好な電氣的接続が得られることを見出したことによりなされたものである。

【0006】

【発明の実施の形態】 本発明を図面を参照しながら説明

する。図1は本発明の一実施例を説明する回路基板の仮接続行程を示す断面図である。本発明に用いる基板1は、半導体チップ類のシリコンやガリウム・ヒ素等や、ガラス、セラミックス、ガラス・エポキシ複合体、プラスチック等の絶縁基板であり、これに対向する基板2も同様な材質からなる。本発明に用いる回路電極1-aは基板1の表面に銅箔で設けたものである。回路電極2-aは基板2の表面に銅箔で設けたもので、金の表面層が形成されている。表面層は金、銀、白金族、または錫のいずれかから選択され、これらを組み合わせて用いてもよい。また、銅/ニッケル/金のように複数の金属を組み合わせて多層構成としてもよい。

【0007】回路電極を設けた基板は接続時の加熱による揮発成分による接続への影響をなくすために、回路接続材料による接続工程の前に予め加熱処理されることが好ましい。加熱処理条件は50℃以上の温度で1時間以上が好ましく、100℃以上の温度で5時間以上がより好ましい。

【0008】本発明に用いる接着剤3は加熱により遊離ラジカルを発生する硬化剤およびラジカル硬化性の物質を必須とする接着剤であり、導電性粒子を所定量分散したラジカル硬化性の異方導電性接着剤としてもよい。この際、導電性粒子の表面は金、銀、または白金族から選択される貴金属であることが好ましい。接着剤3は基板1上に載置形成（仮接続）されている。

【0009】図2は、本発明の一実施例を説明する回路基板の本接続行程を示す断面図である。仮接続構造の後に、基板1の回路電極1-aと基板2の回路電極2-aを位置合わせし、基板2上方より熱板5にて所定時間の加熱加圧を行い本接続を完了する。

【0010】図3(a)、図3(b)は、本発明の一実施例を説明する回路基板の本接続構造を示す断面図である。基板電極1-aと2-aは基板電極どうしの直接接触および/または導電性粒子5を介在した接触により導通し、熱ラジカル硬化性の接着剤により固定されている。

【0011】

【作用】本発明においては、従来のエポキシ樹脂系よりも低温速硬化性に優れかつ可使時間が長い電気・電子用の回路接続が可能となる。

【0012】

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて詳細に説明する。

実施例1

(1) 熱ラジカル硬化性回路接続材料の作製

フェノキシ樹脂（ユニオンカーバイド株式会社製、商品名PKHC、平均分子量45,000）50gを、重量比でトルエン（沸点110.6℃、SP値8.90）/酢酸エチル（沸点77.1℃、SP値9.10）=50/50の混合溶剤に溶解して、固形分40%の溶液とし

た。ラジカル重合性物質としてトリヒドロキシエチルグリコールジメタクリレート（共栄油脂株式会社製、商品名80MFA）を用いた。遊離ラジカル発生剤としてベンゾイルパーオキサイドを用いた。ポリスチレンを核とする粒子の表面に、厚み0.2μmのニッケル層を設け、このニッケル層の外側に、厚み0.04μmの金層を設け、平均粒径10μmの導電性粒子を作製した。固形重量比でフェノキシ樹脂50g、トリヒドロキシエチルグリコールジメタクリレート樹脂50g、ベンゾイルパーオキサイド5gとなるように配合し、さらに導電性粒子を3体積%配合分散させ、厚み80μmのフッ素樹脂フィルムに塗工装置を用いて塗布し、70℃、10分の熱風乾燥により、接着剤層の厚みが35μmの回路接続材料を得た。

(2) 熱ラジカル硬化性接着剤シートの基板上への形成（仮接続）

ライン幅50μm、ピッチ100μm、厚み18μmの銅回路上に2μmのNi層を設け、さらに0.05μmのAu層を設けた回路を500本有するプリント基板上に上記回路接続材料を80℃、1MPa、3sで加熱加圧（仮接続）し、フッ素樹脂フィルムをはがして回路接続材料を載置した。

(3) 本接続

仮接続後、室温で1週間経過した上記仮接続品にライン幅50μm、ピッチ100μm、厚み18μmの表面が銅回路を500本有するフレキシブル基板（FPC）を位置合わせし150℃、3MPaで10秒間加熱加圧して幅2mmにわたり接続した。

【0013】実施例2

回路接続材料が導電性粒子を含有しない他は実施例1と同様の接続方法で接続した。

【0014】実施例3

回路接続材料を仮接続するプリント基板の回路の表面がパラジウム（Pd）である他は実施例1と同様の接続方法で接続した。

【0015】実施例4

回路接続材料を仮接続するプリント基板の回路の表面が錫（Sn）である他は実施例1と同様の接続方法で接続した。

【0016】実施例5

フレキシブル基板を100℃で5時間加熱処理を行った他は他は実施例1と同様の接続方法で接続した。

【0017】実施例6

フレキシブル基板及びプリント基板を100℃で5時間加熱処理を行った他は他は実施例1と同様の接続方法で接続した。

【0018】実施例7

回路接続材料をライン幅50μm、ピッチ100μm、厚み18μmの銅回路を500本有するプリント基板上に80℃、1MPaで加熱加圧（仮接続）し、室温で1

日以内に本接続を行う他は実施例1と同様の接続方法で接続した。

【0019】比較例

基板の回路電極の表面を全て金とした以外は実施例1と同様の接続方法で接続した。

【0020】接続体の評価

(接続抵抗の測定) 回路の接続後、上記接続部を含むFPCの隣接回路間の抵抗値を、初期と、85℃、85%RHの高温高湿槽中に500時間保持した後にマルチメータで測定した。抵抗値は隣接回路間の抵抗150点の平均($\bar{x} + 3\sigma$)で比較した。実施例1では初期の接続抵抗も低く、高温高湿試験後の抵抗の上昇もわずかであり、高い耐久性を示した。また、実施例2～7においても同様に良好な接続信頼性が得られた。これらに対して、比較例では仮接続するプリント基板の回路電極表面がNiと遷移金属であるために酸化還元作用により回路接続材料の硬化が進み、本接続で良好な接続信頼性が得られなかった。

(接着力の測定) 回路の接続後、90度剥離、剥離速度*

*50mm/minで接着力測定を行った。比較例1では300gf/cm程度と接着力が低い、実施例1～7では1000gf/cm程度と良好な接着力が得られた。

【0021】

【発明の効果】本発明においては、従来のエポキシ樹脂系よりも低温速硬化性に優れかつ可使用時間が長い電気・電子用の回路接続が可能となる。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】本発明の一実施例を説明する回路基板の仮接続行程を示す断面図。

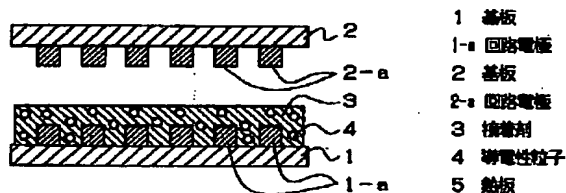
【図2】本発明の一実施例を説明する回路基板の本接続行程を示す断面図。

【図3】本発明の一実施例を説明する回路の接続構造を示す断面図。

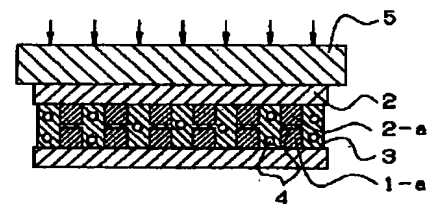
【符号の説明】

1・・・基板、2・・・基板、1-a・・・回路電極、2-a・・・回路電極、3・・・接着剤、4・・・導電性粒子、5・・・熱板

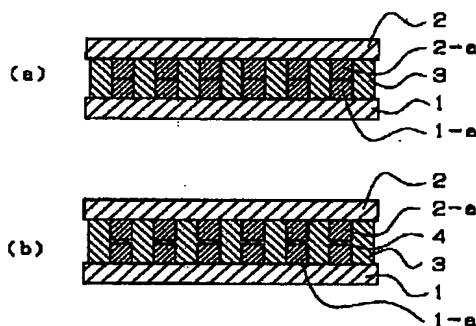
【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(51)Int. Cl. 6

H01L 21/60

識別記号

311

FI

H01L 21/60

311S